

Əməkdaş Məlumat Forması (Kafedra Saytı üçün)

1. Ad, soyad, ata adı: Ləman Abdullayeva Kamal qızı

2. Əlaqə məlumatı: leman.abdullayeva@aztu.edu.az

Telefon: +994557447191

3. Təhsil tarixçəsi: Bakı Dövlət Universiteti - Fizika fakultəsi
1992 - 1997, Fizik, fizika müəllimi ixtisası üzrə;

Fəlsəfə doktoru: Bərk cisim elektronika, radioelektron
komponentlər, mikro- və nanoelektronika – 2009

4. Elmi dərəcə: Fizika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

5. Kafedra: Maşın dizaynı, mexatronika və sənaye texnologiyaları

6. Vəzifəsi: Dosent

7. Hal-hazırda tədris etdiyi fənnlər: İntelektual idarəetmə
sistemlərinin əsasları, Mikroprosessorlar və proqramlaşdırılan integral
mikrosxemlər

8. Tədqiqat sahələri: Metal-yarımkeçirici kontaktların fizikası

9. Özü haqqında məlumat: 1981 – 1991-ci illərdə orta məktəbi,
1992 - 1997 --ci illərdə ali məktəbi bitirmişdir. 2009-cı fizika elmləri
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2015-ci ildən isə hal-
hazırkı müddətə qədər dosent vəzifəsində işləyib. 70-ə yaxın elmi işin
müəllifidir.

10. Elmi Məqalələri:

1. Abdullayeva L.K., Farhadov V.G., Aslanova A.T. Structural Optimization of Schottky Diodes Based on Si. New Materials, Compounds and Applications, 9(2), 2025, pp.380-385
<https://doi.org/10.62476/nmca.92380> (WoS, Q3)
2. La OF, Tran TA, Tran HC, Le SH, Nghiem NT, Truong-Son LV, Khan DT, Abdullayeva LK, Hashimov RF. IMPACT OF Ca DOPING ON THE STRUCTURAL CHARACTERISTICS.

- Advanced Physical Research Vol.6, No.3, 2024, pp.182-190
<https://doi.org/10.62476/apr63182> (**WoS, Q4**)
3. Abdullayeva L.K., Hasanov M.H. Investigation of the role of metal in non-alloy metal-semiconductor (Si) contact. New Materials, Compounds and Applications, 8(1), 2024, 135-141
<https://doi.org/10.62476/nmca8135> (**WoS, Q3**)
 4. Asadullayeva S.G., Ismayilova N.A., Jafarova A.N., Abdullayeva L.K. Analytic method for determining the coercive force of ferromagnetic materials. Advanced Physical Research, 5(2), 2023, 117-121 (**Scopus**)
https://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/APR/V5N2/Asadullayeva_et_al.pdf
 5. Askerov, S. G., Abdullayeva, L. K., Hasanov, M. G. Study of electrophysical properties of metal–semiconductor contact by the theory of complex systems. Journal of Semiconductors, 2020, 41(10), 102101 (**WoS**).
<https://www.researching.cn/ArticlePdf/m00098/2020/41/10/102101.pdf>
 6. Askerov, S.G., Abdullayeva, L.K., Hasanov, M.H. The influence of the metal microstructure on the breakdown mechanism of Schottky diodes. J. Mater Phys Chem, 2018, 1(3), 1.
 7. Afandiyeva I.M., Altındal Ş., Bayramova A.I.. Self-assembled patches in PtSi/n-Si (111) diodes, Journal of Semiconductors, v.39, №5, pp. 054002-1---054002-7, 2018 (**WoS**).
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-4926/39/5/054002/meta>
 8. Аскеров Ш.Г., Эфендиева И.М., Гасанов М.Г. Агамалиева Л.Ф.. Влияние термоотжига на электрофизических свойств Диодов Шоттки, Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər, №1, s.51-54, 2018.
 9. Askerov Sh.Q., Abdullayeva L.K., Hasanov M.H. Origin of discrepancies in the experimental values of the barrier height at metal–semiconductor junctions, Semiconductors , Vol. 51, No. 5, pp. 620–622. 2017 (**WoS**).
<https://link.springer.com/article/10.1134/S1063782617050049>
 10. Аскеров Ш.Г., Гасанов М.Г., Абдуллаева Л.К. Причина расхождения экспериментальных значений высоты барьера контакта металл- полупроводник, ФТП, № 5, т.51, в.5, с.627-629, 2017. (**WoS**).

https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=phts&paperid=6156&option_lang=rus

11. Afandiyeva I.M., Abdullayeva L.K. Altındal Ş., Maril E., Guliyeva T.Z. The investigation of tunnel properties of AL-TiW-PtSi/n-Si (111)(MS) schottky barrier diodes (SBDS) in the wide temperature range, Journal of Qafqaz University, 2014, Number 2, Volume 2, pp.107-118.
12. Afandiyeva I.M., Askerov Sh.G. Dökme İ., Altındal Ş., Abdullayeva L.K. The frequency and voltage dependent electrical characteristics of Al-TiW-Pd₂Si/nSi structure using I-V, C-V and G/w-V measurements. Microelectronic Engineering. 85, 2008, pp.365-370 (WoS).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167931707006454>
13. Afandiyeva I.M., Askerov Sh.G., Abdullayeva L.K., Aslanov Sh.S. The obtaining of Al-Ti₁₀W₉₀/n-Si Schottky diodes and investigation of their interface surface state density. Solid State Electronics, 51, 2007, pp.1096-1100 (WoS).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038110107002043>
14. Abdullayeva L.K. (AL-TiW)-nSi diodların elektrofiziki parametrlərinin həndəsi ölçülərdən asılılığı, BDU-nun xəbərləri, 2006, №4, s.161-164.
15. Эфендиева И.М., Шарбатов В.Х., Алтундал Ш., Абдуллаева Л.К. Флуктуации потенциала диодов (PtSi+TiW-Al)-nSi Azərb.MEA-nın Xəbərləri, 2006, c.XXVI, №2, s.115-118.
16. Əsgərov Ş.Q., Əfəndiyeva İ.M., Abdullayeva L.K., Qəmbərzadə M.A., Ağayev M.N. (Ti₁₀W₉₀— nSi) Şottki baryerinin hündürlüyünün tədqiqi, BU-nun xəbərləri, 1999, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 1, s.93-95.

11. Linklər:

Scopus:

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18433610700>

Googlescholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=rMJfL5cAAAAJ&hl=en&oi=ao>

[ao](#)

Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/L-Lman?ev=hdr_xprf

Web of science:

<https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/2db83a85-7c49-4e11-998d-ed1be29af5d5-017ebc1245/04ec5e39-89bd-4400-bad9-3512b588f420-017ebc1241/relevance/1>